

108 年度工研院 低粗糙度銅箔與高頻基板相關專利讓與案

有鑑於企業在面對市場、技術、產品的激烈競爭時，掌握優質專利可累積強有力的智慧財產權能量，並可藉此提升競爭能力，成為企業在國際間競爭的最佳籌碼。財團法人工業技術研究院擬將其所擁有之優質專利，以讓與之方式提供國內廠商，以增加廠商國際競爭力，促進整體產業發展及提升研發成果運用效益。

一、主辦單位：財團法人工業技術研究院（以下簡稱「工研院」）

二、投標廠商資格：

國內依中華民國法令組織登記成立從事研發、設計、製造或銷售之公司法人。

三、讓與標的：

本讓與案包含低粗糙度銅箔與高頻基板等相關專利共 21 案 51 件（以下簡稱「讓與標的」），目前有 3 案 8 件專利非專屬授權中。「讓與標的」共分為三個類別：（一）銅箔（5 案 9 件）、（二）銅箔基板暨樹脂材料（14 案 35 件）及（三）其他應用（2 案 7 件）。「讓與標的」相關資訊詳如附件，或請參考下述網站：

台灣技術交易資訊網(<https://www.twtm.com.tw/Web/index.aspx>)、及工研院研發成果公告網站

（<https://www.itri.org.tw/chi/Content/Bulletin/list.aspx?&SiteID=1&MmmID=3000&SY=0&CatID=1>）。

四、公開說明會與領標：

1. 公開說明會將於民國（下同）108 年 10 月 15 日 14 時整於工研院中興院區 51 館 110-1 室舉辦。
2. 公開說明會採電子郵件方式報名。有意報名者，請於 108 年 10 月 14 日中午 12 時整（含）前發送電子郵件（請於電子郵件主旨上註明「低粗糙度銅箔與高頻基板相關專利讓與案公開說明會報名」，並請於電子郵件內文中陳明：公司名稱、公司電話、參與人數、姓名、職稱。）予工研院技術移轉與法律中心（以下簡稱「技轉法律中心」）聯絡人（請詳十二、聯絡方式）進行報名。工研院「技轉法律中心」聯絡人將於 108 年 10 月 14 日下午 5 時整（含）前發送電子郵件回覆並告知公開說明會會議資訊。
3. 自本標案公告日起至截標日 108 年 10 月 24 日下午 5 時整(含)止，得洽「技轉法律中心」聯絡人領取標單。

五、投標方法：

1. 本標案採通訊或親送方式投標。投標廠商應按投標單內所列各項目填寫清楚，加蓋投標廠商公司章及負責人章，連同押標金、公司設立證明文件（如營利事業登記證、公司設立核准函、公司登記/變更資料或公司設立登記表影本）、廠商基本資料表（以下統稱「投標文件」），裝入信封密封之，並在信封上註明「低粗糙度銅箔與高頻基板相關專利讓與案投標」，於截標日 108 年 10 月 24 日下午 5 時整（含）前（以送達收據為憑）掛號寄達或親送至：
31057 新竹縣竹東鎮中興路四段 195 號 51 館 110 室
工研院技轉法律中心 方先生 收
2. 本標案採「案」方式投標，「讓與標的」以同一發明為一案。本標案採一案一標，即同一案專利不分開投標/開標。
3. 本標案不得共同投標或重複投標。
4. 投標後除工研院要求或同意外，投標廠商不得以任何理由撤回或修改其投標單。
5. 投標廠商於投標時，不得附加任何條件。

六、押標金：

1. 押標金為總投標金額之 10%，以仟元為最小單位，以下四捨五入。
2. 押標金應以現金、銀行本票或即期支票支付。若以銀行本票或即期支票支付時，請註明受款人為「財團法人工業技術研究院」，並載明禁止背書轉讓。
3. 得標廠商之押標金移充簽約保證金；未得標廠商之押標金，於開標後掛號無息寄回投標廠商。

七、有下列情形之一者，應認為無效投標，無效之投標不進入決標程序：

1. 投標時間截止後之投標。
2. 開標前業已公告停止本標案交易程序。
3. 投標廠商共同投標或重複投標，全部投標均為無效。
4. 投標單附加任何成交條件者。
5. 投標文件之記載不符所定程式或其記載之字跡潦草、模糊，致無法辨識者。
6. 投標文件有所缺漏者。但押標金不足者，工研院得要求投標廠商補足，若於決標前未能補足者，其投標為無效。

八、決標方法：

1. 開標日為 108 年 10 月 25 日。
2. 開標時，先就投標資格、投標單、押標金、公司設立證明文件、廠商基本資料表進行審查及確認。
3. 同一案以投標廠商出價金額最高且高於底價者得標。同一案有二家（含）

以上投標金額相同時，由工研院現場抽籤決之。

4. 開標時將請律師到場監標。
5. 開標後將個別通知投標廠商開標結果（不公告得標廠商）。
6. 對於流標、廢標或無效投標之「讓與標的」，工研院得逕洽第三人為授權或讓與等交易行為，第三人不限於本公告之投標廠商資格。

九、契約事項：

1. 得標廠商應於接獲得標通知起 30 個工作天內，與工研院簽訂「讓與契約書」。各項契約條件應以工研院與得標廠商正式簽訂之「讓與契約書」為準。工研院保留與得標廠商簽訂「讓與契約書」之權利。
2. 得標廠商如屆期末與工研院簽訂「讓與契約書」時，工研院得沒收簽約保證金並取消得標資格（但經工研院同意者，不在此限）；此外，工研院得另洽第三人為授權或讓與等交易行為，第三人不限於本公告之投標廠商資格。
3. 得標廠商與簽訂「讓與契約書」者，須為同一人，否則工研院得沒收簽約保證金並取消得標資格；此外，工研院得另洽第三人為授權或讓與等交易行為，第三人不限於本公告之投標廠商資格。
4. 得標廠商就「讓與標的」同意遵守中華民國相關法令之規定（包括但不限於介入權、境外實施等規定）。前述法令變動時，亦同。
5. 得標廠商取得「讓與標的」應支付工研院讓與費用，讓與費用應以現金支付，但經工研院事前書面同意，得標廠商得以其股票支付，惟其支付方式、內容及相關細節等均應符合工研院之要求。
6. 得標廠商簽署「讓與契約書」且生效時，本標案簽約保證金移充為「讓與契約書」之讓與費用。
7. 「讓與契約書」經雙方依法簽章報經濟部同意後生效。得標廠商充分了解「讓與標的」之讓與依規定須送經濟部核准，且工研院對於經濟部之意見並無影響能力。
8. 得標廠商同意經濟部及/或工研院就「讓與標的」，享有永久、無償、全球、非專屬及不可轉讓之使用、實施其全部或部份之權利。得標廠商嗣後若將「讓與標的」專屬授權或讓與第三人時，並應使該第三人同意本條約定。再為專屬授權或讓與時亦同。
9. 得標廠商應就「讓與標的」之一部或全部，承受於「讓與契約書」生效前：1.工研院已與第三人簽訂之授權契約；2.工研院已承諾第三人未來得取得非專屬授權之權利；及 3.工研院已承諾不會對特定之人或特定產品行使專利權。得標廠商嗣後依政府相關法令規定，將「讓與標的」專屬授權或讓與他人時，並應使該專屬被授權人或受讓人同意本條約定。前述受讓人再為專屬授權或讓與時亦同。
- 10.得標廠商同意並承認，「讓與契約書」僅為工研院同意讓與「讓與標的」

予得標廠商。工研院亦僅依本標案公告日之「讓與標的」現狀辦理本標案並交付得標廠商，工研院不擔保「讓與標的」之尚在申請中之專利可獲證，或可依原始申請範圍獲證，或已獲證專利不會被撤銷、消滅或其範圍不會變更。工研院亦不擔保「讓與標的」有效性、合用性、商品化、無瑕疵、得向第三人主張權利、不侵害第三人之智慧財產權及可達其他特定目的之可能性，且不擔保得標廠商利用「讓與標的」所製造產品之產品責任。「讓與標的」之未獲證或被撤銷，工研院毋須返還或賠償任何款項予得標廠商。得標廠商或第三人因「讓與標的」發生任何損害時，工研院無須負擔任何責任，包括無須負擔相關侵權與瑕疵擔保責任。「讓與契約書」生效後，「讓與標的」之任何舉發、被撤銷或其他糾紛，得標廠商同意自行負責，概與工研院無涉；工研院亦毋須返還或賠償任何款項予得標廠商。此外，工研院並無提供任何有關「讓與標的」之資料文件予得標廠商，或是對得標廠商提供有關「讓與標的」之諮詢講解或訓練之義務。

11. 「讓與標的」之讓與登記手續由得標廠商負責辦理，並由得標廠商負擔讓與手續所須之一切費用。雙方將互相配合以辦理讓與登記手續。得標廠商應自「讓與契約書」生效之日起負擔「讓與標的」之申請維護等相關費用；得標廠商未依規定自行繳費，因而致「讓與標的」發生失效或其他不利益之效果者，概由得標廠商自負其責，工研院毋須為得標廠商之利益繳交專利相關費用或行使任何專利法所規定之權利義務。
12. 「讓與標的」有以下情事之一者，得標廠商同意遵守相關之法令規定，配合工研院為一切必要之申請，並應將其檢視該專利運用行為是否可能導致我國核心競爭力之削弱或影響國內研發創新佈局之報告，事前提供工研院。得標廠商應配合工研院向主管機關(包含但不限經濟部，下同)為一切必要之申請(包括但不限於境外實施之申請等)，並應提供一切相關之文件。得標廠商應於取得工研院及/或主管機關之核准及同意後始得為之：
 - (1) 得標廠商在我國管轄區域(係指台、澎、金、馬，下同)外自行使用、實施者；
 - (2) 得標廠商非專屬授權供非我國研究機構或企業，或在我國管轄區域外製造或使用者；
 - (3) 得標廠商專屬授權供非我國研究機構或企業，或在我國管轄區域外製造或使用者；
 - (4) 得標廠商讓與「讓與標的」之對象非我國研究機構或企業者。

13. 得標廠商如有下列各款情事之一時，經濟部或工研院得終止全部或部

分「讓與契約書」，並得將「讓與標的」非專屬授權他人實施，或於必要時將「讓與標的」收歸國有：

- (1) 得標廠商於合理時間內無正當理由未有效運用「讓與標的」，且他人曾於該期間內以合理之商業條件，請求授權仍不能達成協議者。
- (2) 得標廠商以妨礙環境保護、公共安全或公共衛生之方式實施「讓與標的」者。
- (3) 為增進國家重大利益者。

有本項情形時，工研院已收取得標廠商之各項費用或金額無須返還，亦無須負擔損害賠償責任。

14. 得標廠商依政府相關法令規定將「讓與標的」之全部或一部授權或讓與第三人（以下稱「後手」）時，應將相關授權或讓與對象事前通知工研院，以便工研院向主管機關陳報運用所生之產業效益。
15. 得標廠商應使所有「後手」遵守本條第 8 項至第 10 項、第 12 項至第 14 項、第 16 項及第 17 項之約定。得標廠商應與「後手」約定，如「後手」違反前述約定者，工研院得直接對「後手」主張權利。如「後手」違反前述約定者，視為得標廠商違反前述約定。「後手」再為授權或讓與時，亦同。
16. 基於尊重智慧財產並維護合法授權者之權利，得標廠商欲對第三人就「讓與標的」主張其權利時，應先定合理期間且以合理之商業條件通知該對象請求協商授權事宜。如經前述協商程序仍不能達成協議，而有必要採取法律行動時，應通知工研院。得標廠商於「讓與契約書」生效後對第三人就「讓與標的」以任何方式主張權利時，得標廠商應自行為該行為、進行該程序或訴訟，工研院無參與得標廠商進行該行為、程序或訴訟之義務。
17. 得標廠商於「讓與契約書」生效後，因股權變動而產生或增加陸、港、澳投資時，應於事實發生後 30 日內，以書面通知工研院，工研院若認為有違反政府法令規定或損及我國整體產業及技術發展之虞時，得以書面敘明理由通知得標廠商後解除「讓與契約書」。

十、領標方式：

有意投標者，請與工研院「技轉法律中心」聯絡人（請詳十二、聯絡方式）聯絡，取得投標單。

十一、注意事項：

本標案公告為「讓與契約書」之一部分。投標廠商之投標行為，視為已充分閱讀、了解並同意本公告、「讓與標的」、投標單及相關資訊之內容。各該內容如有不清楚或抵觸者，工研院保留最終之解釋與決定權利。



十二、聯絡方式：

本公告相關問題請洽詢：

工研院「技轉法律中心」 方先生

電話：+886-3-591-4466，傳真：+886-3-582-0466

電子信箱：dennis_fang@itri.org.tw

地址：31057 新竹縣竹東鎮中興路四段 195 號 51 館 110 室



附件：讓與標的清單

專利分類	案次	案編號	件次	件編號	專利中文名稱	申請國家	申請號/專利號	狀態	專利起期	專利迄期	委辦單位	備註
銅箔 (5 案 9 件)	1	P05910039	1	P05910039CN	高高溫伸長率電解銅箔的製造方法	CN	ZL02156049.8	獲證	20070509	20221210	經濟部技術處	
			2	P05910039TW	高高溫伸長率電解銅箔之製造方法	TW	192043	獲證	20031111	20221024	經濟部技術處	
	2	P05910045	3	P05910045CN	具耐折性的電解銅箔的製造方法	CN	ZL02159066.4	獲證	20060412	20221226	經濟部技術處	
			4	P05910045TW	具耐折性之電解銅箔的製造方法	TW	200903	獲證	20040411	20221202	經濟部技術處	
	3	P54020067	5	P54020067TW	厚銅箔結構	TW	I527685	獲證	20160401	20340624	經濟部技術處	
	4	P54030060	6	P54030060CN	厚銅層與其形成方法	CN	ZL201510291125.9	獲證	20180410	20350531	經濟部技術處	
			7	P54030060TW	厚銅層與其形成方法	TW	I598005	獲證	20170901	20350412	經濟部技術處	
	5	P54060023	8	P54060023CN	高頻電路用銅箔及其製造方法	CN	201711419307.5	申請中	申請中	申請中	經濟部技術處	
			9	P54060023TW	高頻電路用銅箔及其製造方法	TW	I652163	獲證	20190301	20371114	經濟部技術處	
銅箔 基板 暨樹脂 材料 (14 案 35 件)	6	024890490	10	024890490TW	具有優異電氣的樹脂組成物	TW	162996	獲證	20020821	20201005	經濟部技術處	
	7	P54020010	11	P54020010CNC1	樹脂組合物、膠片、及包含其的基材	CN	ZL201410174284.6	獲證	20160608	20340427	經濟部技術處	
			12	P54020010TWC1	樹脂組合物、膠片、及包含其之基材	TW	I513761	獲證	20151221	20340410	經濟部技術處	
			13	P54020010US	樹脂組合物、硬化膜、及包含其之基材	US	9,642,249	獲證	20170502	20350801	經濟部技術處	非專屬授權中
	8	P54020019	14	P54020019CN	聚醯胺酸、聚亞醯胺、及石墨片的製作方法	CN	ZL201310672060.3	獲證	20170301	20331210	經濟部技術處	
			15	P54020019JP	聚醯胺酸、聚亞醯胺、及石墨片的製作方法	JP	5805826	獲證	20150911	20340519	經濟部技術處	
			16	P54020019KR	聚醯胺酸、聚亞醯胺、及石墨片的製作方法	KR	10-1597349	獲證	20160218	20340324	經濟部技術處	
			17	P54020019TW	聚醯胺酸、聚亞醯胺、及石墨片的製作方法	TW	I473838	獲證	20150221	20331112	經濟部技術處	
			18	P54020019US	聚醯胺酸、聚亞醯胺、及石墨片的製作方法	US	9,593,207	獲證	20170314	20350609	經濟部技術處	
	9	P54040047	19	P54040047CN	複合積層板	CN	201610630804.9	申請中	申請中	申請中	經濟部技術處	
			20	P54040047TW	複合積層板	TW	I617454	獲證	20180311	20360621	經濟部技術處	



		21	P54040047US	複合積層板	US	15/256,084	申請中	申請中	申請中	經濟部技術處	
10	P54050043	22	P54050043CNC1	膠粘劑組合物及包含其之複合基材	CN	201711404575.X	申請中	申請中	申請中	經濟部技術處	
		23	P54050043TWC1	接著組成物及包含其之複合基材	TW	I652322	獲證	20190301	20371221	經濟部技術處	
		24	P54050043US	接著組成物及包含其之複合基材	US	15/656,652	申請中	申請中	申請中	經濟部技術處	
11	P54050059	25	P54050059CN	銅箔複材	CN	201611257153.X	申請中	申請中	申請中	經濟部技術處	
		26	P54050059TW	銅箔複材	TW	I607866	獲證	20171211	20361229	經濟部技術處	
12	P54060022	27	P54060022CN	底漆組成物與使用該底漆組成物的銅箔基板	CN	201810552437.4	申請中	申請中	申請中	經濟部技術處	
		28	P54060022TW	底漆組成物與使用該底漆組成物之銅箔基板	TW	I07113094	申請中	申請中	申請中	經濟部技術處	
		29	P54060022US	底漆組成物與使用該底漆組成物之銅箔基板	US	16/057,779	申請中	申請中	申請中	經濟部技術處	
13	P54950002	30	P54950002CN	熱塑性聚醯亞胺組合物與雙面軟性銅箔基板的制作方法	CN	ZL200610090842.6	獲證	20090603	20260625	經濟部技術處	
		31	P54950002TW	熱塑性聚醯亞胺組合物與雙面軟性銅箔基板之製作方法	TW	I306882	獲證	20090301	20260524	經濟部技術處	
		32	P54950002US	熱塑性聚醯亞胺組合物與雙面軟性銅箔基板之製作方法	US	7,459,518	獲證	20081202	20270322	經濟部技術處	
14	P54950082	33	P54950082TW	具有高介電性複材之基板結構及其製法	TW	I308470	獲證	20090401	20261227	經濟部技術處	
15	P54950133	34	P54950133TW	難燃性交聯劑及無鹵無磷難燃的環氧樹脂組成物	TW	I347330	獲證	20110821	20270422	經濟部技術處	
16	P54960099	35	P54960099CN	撓曲性、低介電損失組合物及其製造方法	CN	ZL200810008114.5	獲證	20120425	20280203	經濟部技術處	非專屬授權中
		36	P54960099TWC1	撓曲性、低介電損失組合物及其製造方法	TW	I447155	獲證	20140801	20280923	經濟部技術處	非專屬授權中
		37	P54960099US	撓曲性、低介電損失組合物及其製造方法	US	8,138,263	獲證	20120320	20300227	經濟部技術處	非專屬授權中
17	P54980001	38	P54980001CN	電容基板結構	CN	ZL200910165150.7	獲證	20130417	20290722	經濟部技術處	
		39	P54980001TWC1	電容基板結構	TW	I394189	獲證	20130421	20290723	經濟部技術處	
		40	P54980001US	電容基板結構	US	8,390,984	獲證	20130305	20300414	經濟部技術處	
18	P54980043	41	P54980043CN	高介電材料	CN	ZL200910261885.X	獲證	20121114	20291230	經濟部技術處	



			42	P54980043TW	高介電材料	TW	I423281	獲證	20140111	20291222	經濟部 技術處	
	19	P54990061	43	P54990061CN	具有導電膜層的基板組合及其製造方法	CN	ZL20101061644 6.9	獲證	20150121	20301230	經濟部 技術處	
			44	P54990061TW	具有導電膜層的基板組合及其製造方法	TW	I471072	獲證	20150121	20301229	經濟部 技術處	
其他 應用 (2 案 7 件)	20	P54010049	45	P54010049CN	電磁波屏蔽結構及其製造方法	CN	ZL20121058732 4.0	獲證	20170829	20321227	經濟部 技術處	非專屬 授權中
			46	P54010049KR	電磁波屏蔽結構及其製造方法	KR	10-1464322	獲證	20141117	20330703	經濟部 技術處	非專屬 授權中
			47	P54010049TW	電磁波屏蔽結構及其製造方法	TW	I488280	獲證	20150611	20321120	經濟部 技術處	非專屬 授權中
			48	P54010049US	電磁波屏蔽結構及其製造方法	US	9,236,169	獲證	20160112	20330804	經濟部 技術處	非專屬 授權中
	21	P54960094	49	P54960094CNC 1	複合型電容	CN	ZL20121018875 1.1	獲證	20150916	20271227	經濟部 技術處	
			50	P54960094TW	複合型電容	TW	I345797	獲證	20110721	20271220	經濟部 技術處	
			51	P54960094US	複合型電容	US	7,561,410	獲證	20090714	20280317	經濟部 技術處	

註：本公告所包含之專利範圍除專利清單明載外，包含上開專利申請範圍內之延續案、分割案之各國專利。